

# Porte-Wafers Circulaire En Ptfé 6 Pouces Résistant Aux Acides Et Aux Alcalins, Panier De Nettoyage Pour Semi-Conducteurs Personnalisable

Numéro d'article: PL-CP207



## Introduction

Porte-wafers circulaires en PTFE de haute pureté de 6 pouces conçus pour le nettoyage de semi-conducteurs. Excellente résistance aux acides et aux alcalins pour la gravure à la piranha et HF. Paniers usinés de précision, entièrement personnalisables, assurant une manipulation sûre des substrats lors de processus chimiques humides exigeants, de bains d'immersion et de rinçages ultrasonores.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Procédé de nettoyage RCA	Utilisé pour éliminer les résidus organiques, les couches d'oxyde minces et la contamination ionique des wafers de silicium à l'aide de solutions SC-1 et SC-2.	La résistance thermique et chimique élevée empêche la dégradation du porteur lors de l'immersion dans un bain chauffé.
Gravure à la piranha	Manipulation des wafers dans un mélange d'acide sulfurique et de peroxyde d'hydrogène pour éliminer la matière organique lourde.	Une résistance exceptionnelle aux environnements oxydatifs agressifs assure une longue durée de vie de l'équipement.
Trempe à l'acide fluorhydrique (HF)	Élimination des couches d'oxyde sacrificielles ou des oxydes natifs des surfaces de silicium dans diverses concentrations de HF.	La pureté du matériau empêche l'introduction d'ions métalliques dans l'environnement de gravure sensible.
Rinçage post-CMP	Transport des wafers à travers des cycles de nettoyage suite au polissage mécano-chimique (CMP) pour éliminer les particules de boue.	Les surfaces lisses et antiadhésives empêchent le piégeage des particules et facilitent un nettoyage ultrasonore efficace.
Fabrication de cellules solaires	Traitement de wafers de silicium monocristallin ou polycristallin de 6 pouces lors des étapes de texturation et de diffusion du phosphore.	Une construction robuste supporte un débit élevé dans les lignes de production industrielles exigeantes.
Photolithographie	Support des substrats lors du développement et du décapage de la résine photosensible à l'aide de solvants et de décapants spécialisés.	La compatibilité universelle avec les solvants empêche le gonflement ou le ramollissement du cadre du porteur.
Nettoyage ultrasonore	Transport de composants délicats dans des bains ultrasonores ou mégasonores pour l'élimination de contaminants de haute précision.	La rigidité structurelle permet une transmission efficace de l'énergie acoustique aux surfaces des wafers.
Gravure de semi-conducteurs composés	Traitement de wafers GaAs, InP ou SiC dans des mélanges chimiques spécialisés pour la fabrication de dispositifs optoélectroniques.	La géométrie des fentes personnalisable accueille diverses épaisseurs de wafers et des matériaux de substrats fragiles.

Paramètre	Détail de la spécification pour PL-CP207
Identificateur de modèle	PL-CP207
Construction du matériau	PTFE vierge de haute pureté (Options PFA personnalisées disponibles)
Compatibilité de taille de wafer	6 pouces / Diamètre 150 mm
Configuration de la géométrie	Panier de nettoyage circulaire / Type panier fleur
Compatibilité chimique	Résistance universelle (Acides, Bases, Solvants, Oxydants)

Application	Description	Avantage clé
Paramètre	Détail de la spécification pour PL-CP207	
<b>Tolérance de température</b>	Convient pour le traitement cryogénique à haute température	
<b>Capacité de personnalisation</b>	Dimensions, nombre de fentes et configurations de poignée entièrement personnalisables	
<b>Finition de surface</b>	Usiné de précision, ultra-lisse, non poreux	
<b>Capacité du lot</b>	Conçu sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques de nombre de wafers du client	
<b>Méthode de fabrication</b>	Usinage CNC sur mesure / Fabrication personnalisée	